

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M32C/84,85,86,87,88 グループ

フラッシュメモリ版での低消費電力化の応用例

1. 要約

この資料では、フラッシュメモリ版での低消費電力化を行う手順と使用例を紹介します。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコン、条件での利用に適用されます。

- ・マイコン：M32C/84 グループ
M32C/85 グループ
M32C/86 グループ
M32C/87 グループ
M32C/88 グループ

上記マイコンと同様の SFR(周辺機能制御レジスタ)を持つ他の M16C ファミリでも本プログラムを使用することができます。ただし、一部の機能を機能追加等に変更している場合がありますのでマニュアルで確認してください。このアプリケーションノートをご使用に際しては十分な評価を行ってください。

3. 応用例

3.1 低消費電力化実現フロー

低消費電力化を実現するフローチャートを図1に示します。

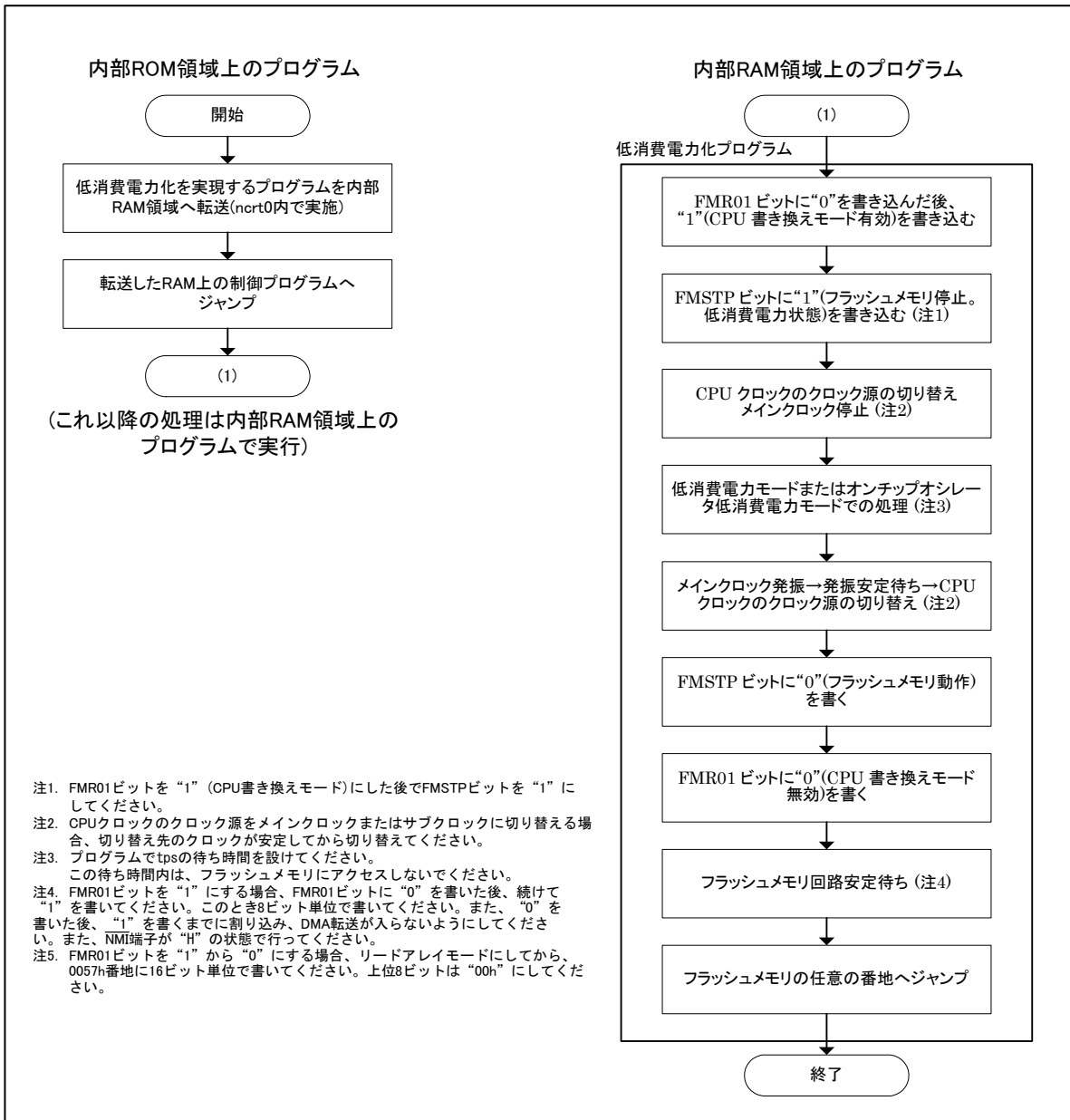


図1. 低消費電力化を実現するフローチャート

3.2 設定手順

3.2.1 低消費電力化プログラムの RAM への転送

低消費電力化を実現するプログラムは RAM 上で動作させる必要があります。ここでは、0FF1000h 番地以降に格納された低消費電力化プログラムを RAM 上に転送する例を説明します。

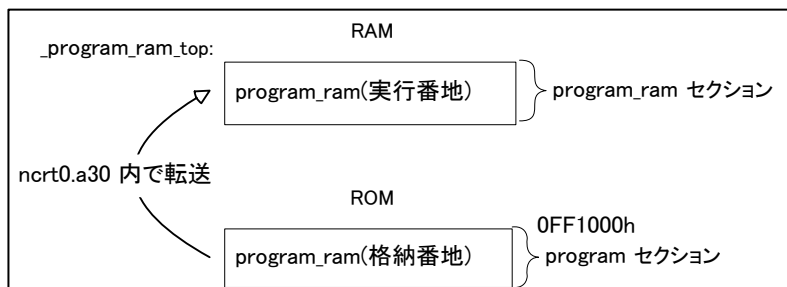


図 2 プログラム配置図

(1) セクション名を変更する。

セクション名として「program_ram」を追加し、このセクションに RAM 上で動作するプログラムを配置します。プログラムを、program セクションから program_ram セクションに配置しなおすには、下記の様に記述します。

```
void main(void)
{
    /* このプログラムは program セクション上に配置される */
}
```

```
/* #pragma SECTION 宣言以降のプログラムは program_ram セクション上に配置される */
#pragma SECTION program program_ram
void low_power(void)
{
    /* このプログラムは program_ram セクション上に配置される */
}
```

(2) sect30.inc の変更

sect30.inc に program_ram セクションを追加します。ここでは、heap セクションの後ろに配置します。また、_program_ram_top ラベルは、プログラム転送時に使用します。

```
-----
; heap section
;-----
        .section heap, DATA
heap_top:
        .blkb    HEAPSIZE
```

```

;-----
; RAM program area
;-----
        .section program_ram, ALIGN
_program_ram_top:
        .glb    _program_ram_top
    
```

ここに追加

(3) プログラムの転送

スタートアップルーチン(ncrt0.a30)にプログラムを RAM に転送する処理を追加します。

```

;-----
; Initialize standard I/O
;-----
        .glb    _init
        .call   _init,G
        jsr.a   _init
    
```

```

;-----
; Program Ram initialize
; _from_addr is defined by as308 option "-D_from_addr=ff1000h"
;-----
        BCOPY  _from_addr, _program_ram_top, program_ram
;
    
```

ここに追加

```

;-----
; Call main() function
;-----
        ldc    #0h, fb          ; for debugger
        .glb   _main
        jsr.a   _main
    
```

(4) プログラム格納位置の指定

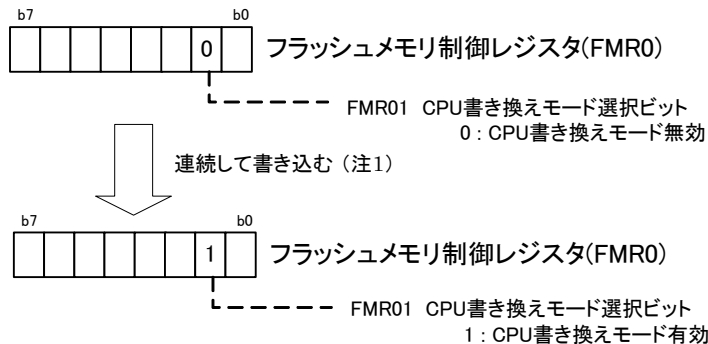
RAM 上に転送したプログラムを実行するには、プログラムの格納番地 (ROM 上) と実行番地 (RAM 上) を別々に配置するようにリンカ (ln308) で指定する必要があります。

```
ln308 -LOC program_ram=0ff1000
```

上記オプションでは、program_ram セクションを 0FF1000h 番地から格納します。

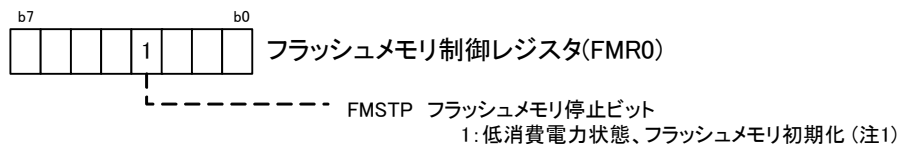
3.2.2 低消費電力化プログラム内の処理

(1)CPU書き換えモードを有効にする。



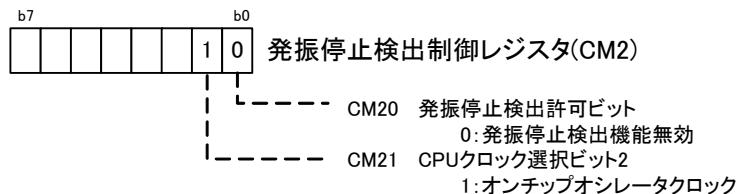
注1. FMR01 ビットを“1”にする場合、FMR01 ビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書いてください。
“0”を書いた後、“1”を書くまでに割り込み、DMA 転送、DMAII転送が入らないようにしてください。
FMR01 ビットへの書き込みは内蔵フラッシュメモリ以外の領域で行ってください。
また、NMI端子が“H”の状態で行ってください。

(2)フラッシュメモリを停止する。

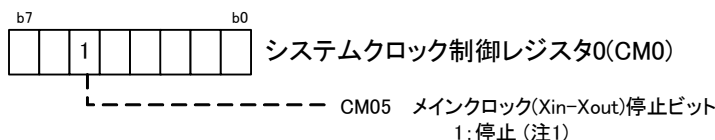


注1. このビットは、内蔵フラッシュメモリ以外の領域のプログラムで書いてください。
FMR01ビットが“1”(CPU書き換えモード有効)のとき有効です。FMR01ビットが“0”のとき、FMSTP
ビットに“1”を書くとFMSTPビットは“1”になりますが、フラッシュメモリは低消費電力状態にはな
らず、初期化もされません。

(3)CPU クロック源をオンチップオシレータクロックに変更する。(オンチップオシレータを使用する場合)



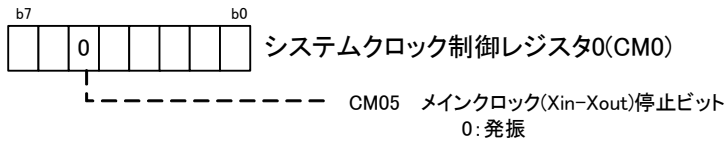
(4)メインクロックを停止する。



注1. このビットは低消費電力モード、またはオンチップオシレータ低消費電力モードにするときに、メイン
クロックを停止させるためのビットです。メインクロックが停止したかどうかの判定には使用できませ
ん。メインクロックを停止させる場合、次のようにしてください。
(1) サブクロックが安定して発振している状態で、CM07ビットを“1”(サブクロック選択)にする、ま
たはCM2レジスタのCM21ビットを“1”(オンチップオシレータ選択)にする。
(2) CM2レジスタのCM20ビットを“0”(発振停止、再発振検出機能無効)にする。
(3) CM05ビットを“1”(停止)にする。

(5) オンチップオシレータクロック低消費電力時に動作するユーザプログラムを実行する。

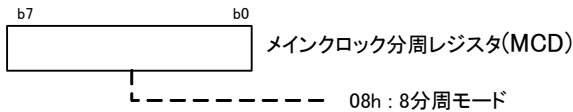
(6) メインクロックを発振する。



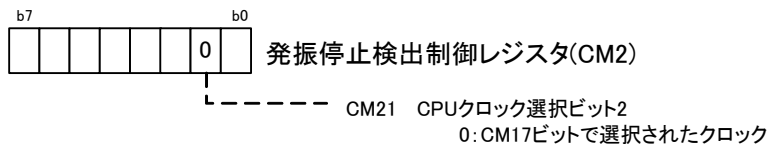
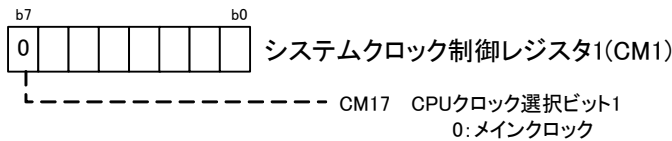
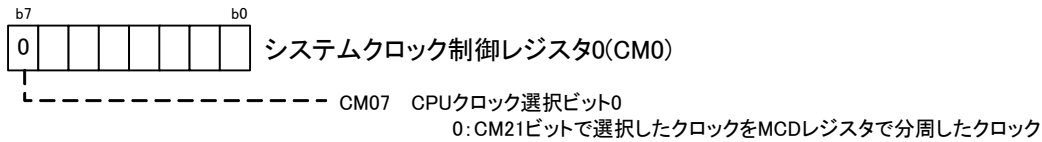
(7) メインクロックの発振が安定するまで約1ms(注1)待つ。

注1. 本資料ではメインクロックの発振安定時間を1msにしています。
発振安定時間は発振子の種類等で異なりますので、御使用になられる発振子の発振が安定するまで待つようにしてください。

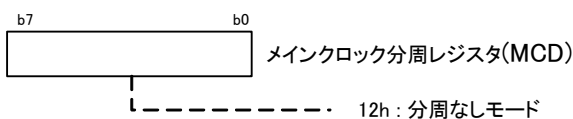
(8) メインクロック分周比を8分周に設定する。



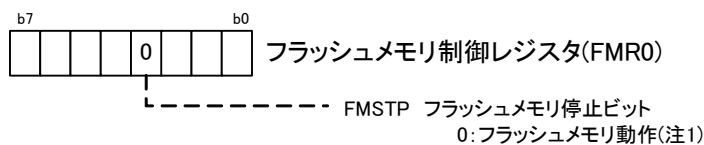
(9) CPU クロック源をメインクロックに変更する。



(10) メインクロック分周比を分周なしモードにする。

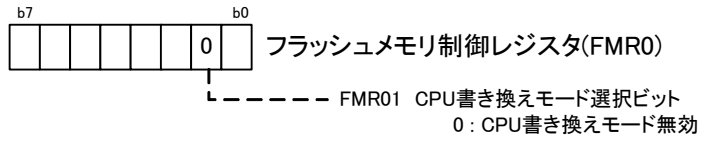


(11) フラッシュメモリを動作させる。



注1. このビットは、内蔵フラッシュメモリ以外の領域のプログラムで書いてください。
FMR01ビットが“1”(CPU書き換えモード有効)のとき有効です。FMR01ビットが“0”のとき、FMSTPビットに“1”を書くとFMSTPビットは“1”になりますが、フラッシュメモリは低消費電力状態にはならず、初期化もされません。

(12) CPU 書き換えモードを無効にする。



(13) フラッシュメモリ回路が安定するのを待つ。
フラッシュメモリ回路安定待ち時間(tPS)分を待つ。

(14) フラッシュメモリの任意の番地にジャンプする。

4. 参考プログラム例

参考プログラムは、ルネサステクノロジホームページから入手してください。M16Cファミリのトップページの画面左メニュー「アプリケーションノート」をクリックしてください。

5. 参考ドキュメント

ハードウェアマニュアル

M32C/84 グループハードウェアマニュアル

M32C/85 グループハードウェアマニュアル

M32C/86 グループハードウェアマニュアル

M32C/87 グループハードウェアマニュアル

M32C/88 グループハードウェアマニュアル

(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジM16Cホームページ

<http://japan.renesas.com/m16c>

ルネサス製品全般に関するお問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail : csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2006.07.21	-	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりますとは、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。